



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100420003

2010 年 4 月 23 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

営業・技術本部 カスタムドキュメント

マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA(ハイパフォーマンスアナログ) ADS12xx 製品 前処理サイト変更予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☒ Initial notice (Plan)	☐ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☒ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Assembly	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	HPA(ハイパフォーマンスアナログ) ADS12xx製品 前処理サイト変更 現行：OKI社(日本) 変更後：TI-Sherman(米国)	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	8月上旬の出荷より予定しています。	
品質認定試験	☒ 計画	☐ 終了
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり
備考	－	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、本PCNの更新版として認定試験の結果を含め、変更品の出荷に先立つ90日以前に、変更通知の発行をもって連絡させていただきます。

弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) ADS12xx製品の前処理サイトについて、現行 OKI社(日本)サイトにおいて5インチウェーハを使用して製造いたしておりますが、OKI社プロセス製造終了及び供給能力確保の為に、これに替えて、TI-Sherman(米国)サイトにおいて6インチウェーハを使用した製造に移行する予定です。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
前処理サイト	OKI社(日本)	TI-Sherman(米国)
ウェーハサイズ	5インチ	6インチ

理由: OKI 社プロセス製造終了及び供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
ADS1201U	ADS1210U/1KG4	ADS1211U	ADS1212U/1KG4	ADS1213U
ADS1201U/1K	ADS1210UG4	ADS1211U/1K	ADS1212UG4	ADS1213U/1K
ADS1201U/1KG4	ADS1211E	ADS1211U/1KG4	ADS1213E	ADS1213U/1KG4
ADS1201UG4	ADS1211E/1K	ADS1211UG4	ADS1213E/1K	ADS1213UG4
ADS1210P	ADS1211E/1KG4	ADS1212P	ADS1213E/1KG4	
ADS1210PG4	ADS1211EG4	ADS1212PG4	ADS1213EG4	
ADS1210U	ADS1211P	ADS1212U	ADS1213P	
ADS1210U/1K	ADS1211PG4	ADS1212U/1K	ADS1213PG4	

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載の前処理サイト記号(ラベルの"20L"の箇所)及び生産国記号(ラベルの"21L"の箇所)及びラベル上の表示位置は、下記の様になる予定です。

	現行	追加認定
Fab Site: 前処理サイト	OKI	TI-Sherman
Chip Site Origin (20L): 前処理サイト記号	OKI	SHE
Chip Country Origin (21L): 生産国記号	JPN	USA



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2009 年 3 月	終了	2010 年 5 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ADS1201U		ADS1210U	
Die Size (mm):	2.2352 X 3.6322		3.6322 X 6.2992	
Wafer Fab Site:	SFAB, SH-BIP-1		SFAB, SH-BIP-1	
Die Protective Coating:	2kA/8.5kA (PSG+ SiN)		2kA/8.5kA (PSG+ SiN)	
Metallization:	Al-Si (0.5%) 10kA		Al-Si (0.5%) 10kA	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		ADS1201U	ADS1210U	
Electrical Characterization	Over Temp	30	30	
Manufacturability	Per mfg. Site specification	Per Spec	Per Spec	

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2009 年 3 月	終了	2010 年 5 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ADS1211U	Die Size (mm):	3.6322 X 6.2992	
Wafer Fab Site:	SFAB, SH-BIP-1	Die Protective Coating:	2kA/8.5kA (PSG+ SiN)	
Metallization:	Al-Si (0.5%) 10kA	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Steady-state Life Test	150C,168, 300 Hrs	77	77	77
Electrical Characterization	Side by side	10	10	10
**High Temp. Storage Bake	170C, 168, 420hrs	77	77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**Temp Cycle	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
ESD HBM	500V, 1000V, 1500V, 2000V	3	3	3
ESD CDM	200V, 500V	3	3	3
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76	76	76
Electromigration	-	Per Spec	Per Spec	Per Spec
Die Shear	-	10	10	10
Latch-up	per JESD78	6	6	6
Manufacturability	per mfg. Site specification	Per Spec	Per Spec	Per Spec
FTY and Bin Summary	-	Per Spec	Per Spec	Per Spec
Manufacturability (Wafer Fab)	-	Per Spec	Per Spec	Per Spec
Note: ** Preconditioning required, JEDEC Level-1 / 220C				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2009 年 3 月	終了	2010 年 5 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ADS1212U		ADS1213U	
Die Size (mm):	6.2992 X 3.6322		3.6322 X 6.2992	
Wafer Fab Site:	SFAB, SH-BIP-1		SFAB, SH-BIP-1	
Die Protective Coating:	2kA/8.5kA (PSG+ SiN)		2kA/8.5kA (PSG+ SiN)	
Metallization:	Al-Si (0.5%) 10kA		Al-Si (0.5%) 10kA	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		ADS1212U	ADS1213U	
Electrical Characterization	Over Temp	10	10	
Manufacturability	Per mfg. Site specification	Per Spec	Per Spec	